
	<h2>SIA430DJ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA430DJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 12A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SIA430DJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22634 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA430DJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 12A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22634 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 12A (Tc) 3.5W (Ta), 19.2W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19.2W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13.5 mOhm @ 7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIA430DJ-T1-GE3TR

SIA430DJ-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIA430DJ-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIA430DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIA430DJ-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIA427DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 12A SC-70-6</p>	 <p>SIA430DJT-T1-GE3 VISHAY VISHAY QFN-6</p>	 <p>SIA430DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA430DJT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12A SC70-6</p>
 <p>SIA430DJT-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN-6</p>	 <p>SIA431DJ VISHAY SIA431DJ VISHAY</p>	 <p>SIA427ADJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 12A 6SC-70</p>	 <p>SIA429DJT-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A SC-70</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIA408DJ-T1-GE3	↔ SIA411DJ-T1-GE3	⇒ SIA411DJ-T1-GE3	D SIA413DJ-T1-GE3	↔ SIA413DJ-T1-GE3
↳ SIA413DJ-T4-GE3	⊛ SIA414DJ-T1-GE3	D SIA414DJ-T1-GE3	⇒ SIA415DJ-T1-GE3	↔ SIA415DJ-T1-GE3
⊛ SIA417DJ-T1-GE3	↳ SIA417DJ-T1-GE3	⊛ SIA419DJ	↔ SIA419DJ-T1-GE3	↔ SIA419DJ-T1-GE3
D SIA421DJ-T1-GE3	⊛ SIA421DJ-T1-GE3	↳ SIA425EDJ-T1-GE3	⊛ SIA425EDJ-T1-GE3	↔ SIA426DJ-T1-GE3
⇒ SIA426DJ-T1-GE3	↔ SIA427DJ-T1-GE3	⊛ SIA427DJ-T1-GE3	↳ SIA429DJT-T1-GE3	↔ SIA429DJT-T1-GE3
↔ SIA430DJ-T1-GE3	⇒ SIA431DJ	D SIA431DJ-T1	⊛ SIA431DJ-T1-GE3	↳ SIA431DJ-T1-GE3
⊛ SIA432DJ-T1-GE3	D SIA432DJ-T1-GE3	⇒ SIA433EDJ	↔ SIA433EDJ-T1-GE3	↔ SIA433EDJ-T1-GE3
↳ SIA436DJ-T1-GE3	⊛ SIA436DJ-T1-GE3	↔ SIA443DJ-T1-GE3	⇒ SIA443DJ-T1-GE3	↔ SIA444DJT-T1-GE3
⊛ SIA444DJT-T1-GE3	↳ SIA445EDJ-T1-GE3	⊛ SIA445EDJ-T1-GE3	D SIA447DJ-T1-GE3	↔ SIA447DJ-T1-GE3
↔ SIA448DJ-T1-GE3	⊛ SIA448DJ-T1-GE3	↳ SIA449DJ-GE3	⊛ SIA450DJ-T1-GE3	↔ SIA450DJ-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited